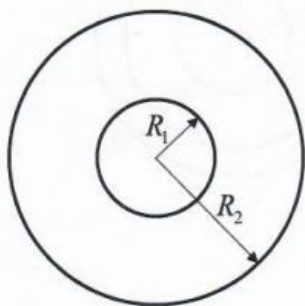


恒定电场作业

1. (1分) 在导电媒质中, 电荷的体密度为 $\rho = \nabla \left(\frac{\epsilon}{\gamma} \right) \cdot \vec{J}$ 。当导电媒质为均匀媒质时, ϵ 和 γ 都不随空间位置变化, 因此电荷密度为零。另一方面, 由定义可知, 体电流密度为电荷体密度乘以电荷的运动速度。试解释均匀导电媒质中体电流密度不为零而体电荷密度为零这一“矛盾”。

答: 不矛盾。因为体电流密度指的是运动电荷的密度, 不是全部电荷的密度; 而体电荷密度指全部的自由电荷 (包括静止的)。

2. (4分) 球形电容器内半径 $R_1 = 5\text{cm}$, 外半径 $R_2 = 10\text{cm}$, 内外导体间的非理性电介质的电导率 $\gamma = 10^{-9}\text{S/m}$, 若内外导体间电压 $U_0 = 1000\text{V}$, 求内外导体间的 φ 、 \vec{E} 、 \vec{J} 和绝缘电阻 R 。



解: 假设内外导体间的漏电流为 I , 则内外导体间的电流密度为: $\vec{J} = \frac{I}{4\pi r^2} \vec{e}_r$

则内外导体之间的电场为: $\vec{J} = \gamma \vec{E} \Rightarrow \vec{E} = \frac{\vec{J}}{\gamma} = \frac{I}{4\pi \gamma r^2} \vec{e}_r$

\therefore 内外导体之间的电压为: $U_0 = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{I}{4\pi \gamma r^2} dr$

$$\Rightarrow U_0 = \frac{I}{4\pi \gamma} \left(-\frac{1}{r} \right) \Big|_{R_1}^{R_2} = \frac{I}{4\pi \gamma} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{I}{4\pi \gamma} \frac{(R_2 - R_1)}{R_1 R_2}$$

$$\Rightarrow \frac{I}{4\pi \gamma} = \frac{U_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1} = \frac{1000 \times 50 \times 10^{-4}}{5 \times 10^{-2}} = 100$$

内外导体之间的电位为，

$$\psi = \int_{R_1}^{R_2} \frac{I}{4\pi r \epsilon_0} dr = \frac{I}{4\pi \epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

∴ 内外导体之间的电位： $\psi = 100 \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \text{ V}$

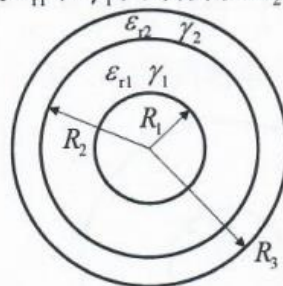
内外导体之间的电场： $E = \frac{100}{r^2} \vec{e}_r \text{ V/m}$

内外导体之间的电流密度： $J = \frac{10^{-7}}{r} \vec{e}_r \text{ A/m}^2$

内外导体之间的绝缘电阻

$$R = \frac{U_0}{I} = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \frac{(R_2 - R_1)}{R_1 R_2} = 7.96 \times 10^8 \Omega$$

3. (5分) 同轴电缆内导体半径为 R_1 ，外导体半径为 R_3 ，内外导体之间有两层媒质。内层从 R_1 到 R_2 ，媒质的参数为 ϵ_{r1} 和 γ_1 ；外层从 R_2 到 R_3 ，媒质的参数为 ϵ_{r2} 和 γ_2 ，如图所示。求



(1) 每层单位长度的电容；

(2) 每层单位长度的电导；

(3) 单位长度的总电容；

(4) 单位长度的总电导；

(5) 当同轴电缆长度为 L ，内外导体之间的电压为 U ，忽略边缘效应，利用边界上的衔接条件分别求界面 R_1 、 R_2 和 R_3 上的电荷面密度。

解：(1) 由电容对比可知：

第一层单位长度电容为： $C_1' = \frac{2\pi \epsilon_{r1} \epsilon_0}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$

第二层单位长度电容为： $C_2' = \frac{2\pi \epsilon_{r2} \epsilon_0}{\ln \frac{R_3}{R_2}}$

(2) 假设同轴电缆内外导体之间的漏电流为 I , 则

当 $R_1 < \rho < R_2$ 时 (第一层)

$$J_1 = \frac{I}{2\pi \rho L} \vec{e}_\rho \Rightarrow \vec{E}_1 = \frac{J_1}{\gamma_1} = \frac{I}{2\pi \gamma_1 \rho L} \vec{e}_\rho$$

$$U_1 = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E}_1 \cdot d\vec{\rho} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{I}{2\pi \gamma_1 \rho L} d\rho = \frac{I}{2\pi \gamma_1 L} \ln \frac{R_2}{R_1}, \text{ 令 } L=1\text{m},$$

$$\therefore \text{第一层单位长度电导为: } G'_1 = \frac{I}{U_1} = \frac{2\pi \gamma_1}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$

$$\text{同理: 第二层单位长度电导为 } G'_2 = \frac{2\pi \gamma_2}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$

(3) 单位长度总电导为

$$C = \frac{2\pi \epsilon_0}{\frac{1}{\epsilon_{r1}} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{\epsilon_{r2}} \ln \frac{R_2}{R_1}}$$

(4) 单位长度总电导为

$$G = \frac{I}{U_1 + U_2} = \frac{I}{\frac{I}{2\pi \gamma_1 \ln \frac{R_2}{R_1}} + \frac{I}{2\pi \gamma_2 \ln \frac{R_2}{R_1}}} = \frac{2\pi}{\frac{1}{\gamma_1} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{\gamma_2} \ln \frac{R_2}{R_1}}$$

(5) 欲求界面上的电荷密度, 需求介质中的 \vec{E} 和 \vec{D}

已知内外导体之间的电压为 U , 则

$$U = U_1 + U_2 = \frac{I}{2\pi \gamma_1 L} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{I}{2\pi \gamma_2 L} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$\Rightarrow \frac{I}{2\pi L} = \frac{U}{\frac{1}{\gamma_1} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{\gamma_2} \ln \frac{R_2}{R_1}}$$

$$\therefore \vec{E}_1 = \frac{I}{2\pi \gamma_1 \rho L} \vec{e}_\rho = \frac{U}{(\frac{1}{\gamma_1} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{\gamma_2} \ln \frac{R_2}{R_1}) \rho} \vec{e}_\rho \quad R_1 < \rho < R_2$$

$$\therefore \vec{E}_2 = \frac{I}{2\pi \gamma_2 \rho L} \vec{e}_\rho = \frac{U}{(\frac{1}{\gamma_1} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{\gamma_2} \ln \frac{R_2}{R_2}) \rho} \vec{e}_\rho \quad R_2 < \rho < R_3$$

$$\text{则: } \vec{D}_1 = \frac{\epsilon_{r1} \epsilon_0 U}{(\frac{1}{\gamma_1} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{\gamma_2} \ln \frac{R_2}{R_2}) \rho} \vec{e}_\rho \quad R_1 < \rho < R_2$$

$$\vec{D}_2 = \frac{\epsilon_{r2} \epsilon_0 U}{(\frac{1}{\gamma_1} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{\gamma_2} \ln \frac{R_2}{R_2}) \rho} \vec{e}_\rho \quad R_2 < \rho < R_3$$

$\rho = R_1$ 的界面是内导体和电介质的分界面, 分界面的法线方向为 \vec{e}_ρ

$$\therefore \sigma|_{\rho=R_1} = D_1 = \frac{\epsilon_{r1} \epsilon_0 U}{(\frac{1}{\gamma_1} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{\gamma_2} \ln \frac{R_2}{R_2}) \rho}$$

$\rho=R_2$ 的分界面是两电介质的分界面, 分界面的法线方向为 \vec{e}_ρ

$$\therefore \sigma|_{\rho=R_2} = D_{2n} - D_{1n} = \frac{\epsilon_0 U}{(\frac{1}{\gamma_1} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{\gamma_2} \ln \frac{R_3}{R_2}) R_2} (\frac{\epsilon_n}{\gamma_2} - \frac{\epsilon_{n1}}{\gamma_1})$$

$\rho=R_3$ 的分界面是介质和导体的分界面, 分界面的法线方向为 $(-\vec{e}_\rho)$

$$\therefore \sigma|_{\rho=R_3} = -D_{2n} = \frac{-\epsilon_{n2} \epsilon_0 U}{(\frac{1}{\gamma_1} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{\gamma_2} \ln \frac{R_3}{R_2}) R_3}$$

4. (1分) 假设大地为均匀导电媒质, 浅埋于地下的不规则形状接地

体电流流入大地。在远离接地体的大地内, 电流如何分布?

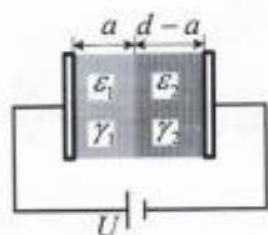
解: 接地体为良导体, 大地为不良导体, 根据良导体和不良导体分界面条件, 良导体的电流垂直进入不良导体, 所以接地体电流垂直流入大地, 在远离接地体的大地内, 电流可近似地看做是半球对称分布。

5. (3分) 图示平行平板电容器, 两极板间距为, 极板之间有两种电

介质, 第一种电介质厚度为, 介电常数为, 电导率为; 第二种电介质

厚度为, 介电常数为, 电导率为。若两极板间加电压, 求电介质中的

电场强度、漏电流密度和电介质分界面上的自由电荷面密度。



根据衔接条件可知:

两种介质中的 J 相等。

$$\begin{cases} E_1 a + E_2 (d-a) = U \\ \gamma_1 E_1 = \gamma_2 E_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} E_1 = \frac{U \gamma_2}{(\gamma_2 - \gamma_1) a + \gamma_1 d} \\ E_2 = \frac{U \gamma_1}{(\gamma_2 - \gamma_1) a + \gamma_1 d} \end{cases}$$

漏电流密度: $J_1 = J_2 = \frac{\gamma_1 \gamma_2 U}{(\gamma_2 - \gamma_1) a + \gamma_1 d}$

电介质分界面上自由电荷面密度为:

$$\sigma_f = D_{2n} - D_{1n} = \frac{(\epsilon_2 \gamma_1 - \epsilon_1 \gamma_2) U}{(\gamma_2 - \gamma_1) a + \gamma_1 d}$$

6. (2分) 在恒定电场的电源中, 总的电场强度闭合线积分为零吗?

局外电场强度的闭合线积分为零吗? 库仑电场强度的闭合线积分为

零吗? 在电源之外, 上述3个闭合线积分是否为零?

在恒定电场的电源中, 有局外场, 所以总场强闭合线积分不为零; 局外电场强度的闭合线积分不为零。

库仑电场强度的闭合线积分为零。

电源之外, 只存在库仑场, 所以闭合线积分为0。

7. (2分) 请依据电流密度矢量 \vec{J} 的定义及电流连续性定理, 分别给出电路理论中焦耳定律(微分形式)与基尔霍夫电流定律的推导过程。

证明(1) 焦耳定律。

导体内的电荷 dq , 以速度 \vec{v} 运动, 则电场力对其做功为:

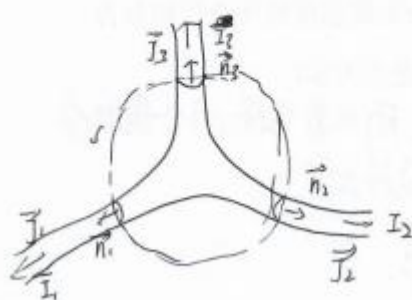
$$dA = \vec{J} \cdot d\vec{l} = dq \vec{E} \cdot d\vec{l} \Rightarrow dA = dq \vec{E} \cdot \vec{v} dt \Rightarrow dA = \rho dV \vec{E} \cdot \vec{v} dt$$

$$d\vec{l} = \vec{v} dt$$

则单位时间的功为 $dp = \frac{dA}{dt} = \vec{E} \cdot \rho \vec{v} dV = \vec{J} \cdot \vec{E} dV$

$$\Rightarrow p = \frac{dA}{dt} = \vec{J} \cdot \vec{E}$$

证明(2) KCL。



在恒定场中, $\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = 0$

$$\Rightarrow 0 = \int_{S1} \vec{J}_1 \cdot d\vec{S}_1 + \int_{S2} \vec{J}_2 \cdot d\vec{S}_2 + \int_{S3} \vec{J}_3 \cdot d\vec{S}_3$$

$$\Rightarrow 0 = I_1 + I_2 + I_3$$

即流出节点电流代数和为零。